

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第7部門第2区分
【発行日】令和5年9月25日(2023.9.25)

【国際公開番号】WO2023/286432
【出願番号】特願2023-535154(P2023-535154)

【国際特許分類】
H01L21/52(2006.01)

【FI】

H01L21/52

A

10

【手続補正書】

【提出日】令和5年7月3日(2023.7.3)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0055

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0055】

次に、図19に示すように、図17に示した半導体チップ3の下面に形成された上側接合層2fと、絶縁回路基板1の上面に形成された下側接合層2eとを張り合わせ、加圧及び加熱することにより、絶縁回路基板1と半導体チップ3とを接合層(2e, 2f)を介して接合する。第4実施形態に係る半導体装置の製造方法の他の手順は、第1実施形態に係る半導体装置の製造方法と同様であるので、重複した説明を省略する。

20

30

40

50